

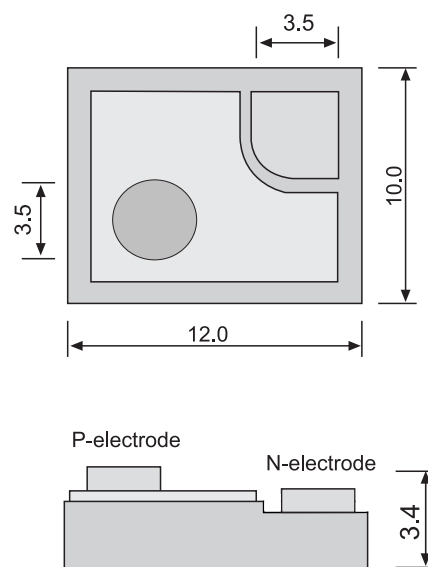


◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 低电流驱动, 损耗小
- 户内外应用
- 波长和光强良好的一致性

◆ 物理参数:

P电极	金
N电极	金
芯片尺寸	12mil x 10mil (305 ± 20μm x 255 ± 20μm)
芯片厚度	3.4mil (85μm ± 15μm)
焊盘尺寸	3.5mil (90 ± 10μm) in diameter



单位: mil

◆ 光电参数: ($T_C=22^{\circ}\text{C}$, $I_F=20\text{mA}$)

产品型号	波长均值范围 (WLD, nm)	正向电压均值范围 (V_F , V)	光强均值范围 (I_v , mcd)
S-12BBAU*-W	450 - 475	3.0 - 3.6	30 - 80

◆ 其它说明

- 光电参数均系三安光电测试仪器在晶圆条件下测试
- 芯片封装工艺最高温度低于 280°C , 持续时间小于10秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 $\pm 1.0\text{nm}$
- 可根据客户要求订做特殊规格的芯片